

*Исследования в ЖЭТФ, том 13; стр. 724 – 728*

*20 июня 1971 г.*

## **НАКАПЛИВАЮЩИЕСЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛЕ НАКАЧКИ С ШИРОКИМ ЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ**

*C. A. Ахманов, Ю. Е. Дьяков, А. С. Чиркин*

**1.** В настоящей статье обсуждается возможность реализации экспоненциального нарастания интенсивности световых волн за счет нелинейного взаимодействия (комбинационного или параметрического) с широкополосной некогерентной накачкой.

**2.** Теоретические исследования комбинационных и параметрических процессов в поле шумовой накачки, выполненные к настоящему времени, не дают полной картины явления. Теория ВКР и ВРМБ в поле некогерентной накачки развита лишь для недиспергирующей среды (см. [5–7]); в отношении параметрического усиления имеются лишь частные результаты [8, 9].

Нами развита теория [13] параметрических и комбинационных процессов в поле некогерентной накачки, в которой учитывается конечное время релаксации нелинейности и дисперсия среды. Показано, что хотя расширение спектра накачки, вообще говоря, снижает эффективность указанных процессов, увеличение спектральной плотности накачки способно скомпенсировать этот эффект<sup>1)</sup>, а именно эффективная полоса частотного (или углового) спектра накачки, вовлекаемого в процесс усиления данной спектральной компоненты сигнала,  $\Delta\omega_n^{\text{ЭФФ}}$  определяется отношением нелинейности среды к ее дисперсии и прямо пропорциональна средней спектральной плотности накачки.

<sup>1)</sup> Сказанное не относится к случаю, когда параметры накачки меняются регулярным образом: например, при достаточно быстром изменении частоты накачки по линейному закону происходит резкий спад усиления при любом уровне накачки [10].

3. Нестационарное ВКР в заданном поле накачки  $A_H(t - (z/u_H))$  описывается уравнениями для комплексной амплитуды стоксовой волны  $A_C$  и недиагонального элемента матрицы плотности  $\sigma$  [6]

$$\frac{1}{u_C} \frac{\partial A_C}{\partial t} + \frac{\partial A_C}{\partial z} = \gamma_1 \sigma A_H \left( t - \frac{z}{u_H} \right), \quad (1a)$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \frac{1}{T_2} \sigma = \gamma_2 A_C A_H^* \left( t - \frac{z}{u_H} \right). \quad (1b)$$

Характер процесса рассеяния зависит от соотношения между  $\Delta\omega_H$  и характерной полосой  $\Delta\omega = (\nu z)^{-1}$ , определяемой длиной области рассеяния  $z$  и дисперсией скоростей  $\nu = |u_C^{-1} - u_H^{-1}|$ . При  $\Delta\omega_H \ll \Delta\omega$  (независимо от соотношения между  $\Delta\omega$  и  $\Delta\omega_{\text{сп}} = 2/T_2$ ) средняя интенсивность стоксовой волны экспоненциально нарастает с расстоянием,

$$\langle |A_C^2(t, z)| \rangle = I_C(z) = I_{C0} \exp G_{\text{ког}} z, \quad G_{\text{ког}} = g_0 I_H, \quad (2)$$

где  $g_0 = 2\gamma_1\gamma_2 T_2$  (все параметры здесь и далее нормированы так, что величины  $\langle |A_{C,H}^2| \rangle = I_{C,H}$  имеют размерность плотности мощности). При  $\Delta\omega_H \gg \Delta\omega_{\text{сп}}$ ,  $\Delta\omega$  амплитуду накачки в (1) можно считать  $\delta$ -коррелированным случаем процессом:

$$\langle A_H(t) A_H^*(t') \rangle = 2\pi S \delta(t - t'), \quad S = I_H / \Delta\omega_H, \quad (3)$$

а стоксово поле рассматривать как марковский процесс. Решение уравнений (1), полученное путем сведения их к уравнению Фоккера – Планка, позволяет получить следующее выражение для интенсивности стоксовой волны в сечении  $z$ :

$$I_C(z) = I_{C0} \exp G_{\text{неког}} z, \quad G_{\text{неког}} = \frac{g_0}{\frac{2}{\pi} - S g_0 \nu^{-1}} \frac{\Delta\omega_{\text{сп}}}{\Delta\omega_H} I_H. \quad (4)$$

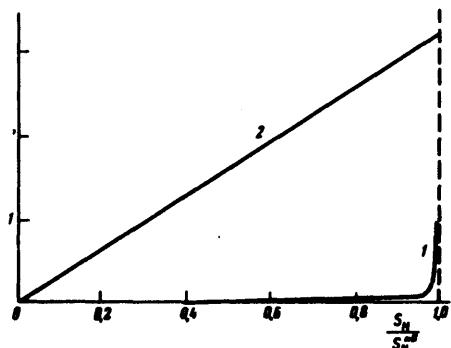
Из сравнения (2) и (4) следует, что величина  $\Delta\omega_H^{\text{ЭФФ}} = \Delta\omega_{\text{сп}} / (\frac{2}{\pi} - S g_0 \nu^{-1})$  быстро возрастает с ростом спектральной плотности накачки (рисунок).

При  $S = S_{\text{кр}} = 2\nu/\pi g_0$  выражение (4) имеет особенность, причем вблизи критического значения  $S$  ширина линии стоксовой компоненты

$$\Delta\omega_C = \frac{4}{\pi} \Delta\omega_H^{\text{ЭФФ}}.$$

Справедливость фоккер-планковского приближения ограничена областью  $\Delta\omega_C < \Delta\omega_H (S < S_{\text{кр}})$ , т. е.  $(\Delta\omega_H^{\text{ЭФФ}})_{\text{max}} \approx (\pi/4) \Delta\omega_H$ .

В области  $S > S_{kp}$  применима квазистатическая формула (2) (см. рисунок). Аналогичные результаты могут быть получены и для других видов рассеяния, в частности, для ВРМБ и ВТР.



Относительная эффективная ширина спектра накачки:  $\eta = \Delta\omega_{\text{ЭФФ}} / \Delta\omega_{\text{Н}}$ , дающая вклад в процессы вынужденного комбинационного рассеяния (кривая 1) и параметрического усиления (кривая 2), как функция средней спектральной плотности накачки

4. Рассмотрим теперь параметрическое усиление (ПУ) в поле накачки, случайно модулированной в пространстве и времени. Если средние частоты сигнала и накачки различаются вдвое, для комплексной амплитуды  $A_c$  усиливаемого сигнала можно написать уравнение [8, 9].

$$\frac{\partial A_c}{\partial z} + \frac{1}{v_c} \frac{\partial A_c}{\partial t} + \beta \frac{\partial A_c}{\partial x} = \gamma A_H (t - \frac{z}{c}, x) A_c^* e^{i\Delta z}, \quad (5)$$

где  $\Delta = k_H - 2k_c$  – расстройка между средними волновыми векторами. В существенно неквазистатическом случае ( $\Delta\omega_H = r_{\text{кор}}^{-1} \gg (\nu z)^{-1}$ ; ширина углового спектра накачки  $\Delta\theta = r_{\text{кор}}^{-1} \gg \Delta\theta_{\text{синх}} = (\beta z)^{-1}$ ) накачку можно считать  $\delta$ -коррелированным процессом в пространстве и времени. Тогда средняя интенсивность волны сигнала в сечении нелинейной среды (на входе,  $z = 0$ , волна сигнала предполагается плоской и монохроматической)

$$\langle |A_c|^2(t, x, z)| \rangle = I_c(z) = I_{c_0} \exp \{ 2[\gamma^2 I_H \ell_{\text{кор}} - \delta]z \},$$

$$\ell_{\text{кор}} = \left( \frac{\nu}{r_{\text{кор}}} + \frac{\beta}{r_{\text{кор}}} \right)^{-1} \quad (6)$$

(в поле монохроматической накачки при  $\Delta = 0$

$$I_c(z) = I_{c_0} \exp \{ 2(\gamma \sqrt{I_H} - \delta)z \}.$$

Для эффективной ширины частотного спектра накачки находим в этом случае  $\Delta\omega_{\text{Н}}^{\text{ЭФФ}} = (2\pi\gamma/\nu)^2 S$ .

5. Для расчетов формулу для  $S_{kp}$  запишем: для ВКР-вперед  $S_{kp} = (I_H/\Delta\nu_H)_{kp} = 4\nu'/g_o$  (здесь  $\Delta\nu_H$  – полоса накачки в  $\text{см}^{-1}$ ,  $\nu' = c\nu$ ), для ВКР-назад и ВРМБ  $S_{kp} = 8/g_o$ . В оптическом диапазоне для ВКР-вперед  $\nu' \approx 10^{-2}$ ,  $g_o \approx 10^{-2} \text{ см}/M_{\text{см}}$  и  $S_{kp} = 4 M_{\text{см}}/\text{см}$ .

Таким образом ВКР-вперед в поле многомодового лазера с весьма широким спектром  $\Delta\nu_H = 100 \text{ см}^{-1}$  (такие полосы характерны для многомодовых лазеров на стекле и красителях) происходит столь же эффективно, как и в поле одномодовой накачки, при относительно невысокой плотности мощности  $\approx 400 \text{ Мвт/см}^2$ . Для ВКР-назад при тех же данных  $S_{kp} \approx 800 \text{ Мвт/см}$ , что приводит к сильной асимметрии вперед-назад. Для ВРМБ в  $CS_2$   $S_{kp} \approx 160 \text{ Мвт/см}$  и, следовательно, нетрудно получить  $\Delta\nu_H^{\text{ЭФФ}} \approx \Delta\nu_H \approx 100 \text{ см}^{-1}$ .

6. Для параметрического усиления  $S_{kp} = \Delta\nu_H (\nu'/\nu)^2$  Для кристалла типа KDP в видимом диапазоне  $\chi^{-2} \approx 25 \text{ Мвт}$ ,  $\nu' \approx 10^{-2}$  и  $S_{kp} \approx (\Delta\nu_H/400) \text{ Мвт/см}^2$ . При  $\Delta\nu_H \approx 100 \text{ см}^{-1}$   $I_{H, kp} \approx 25 \text{ Мвт/см}^2$ . Таким образом эффективная накачка ПГС в видимой и ИК областях возможна с помощью многомодовых лазеров. Последнее позволяет расширить класс источников накачки ПГС и наиболее эффективно использовать нелинейные кристаллы. В УФ диапазоне для накачки ПГС можно использовать лазеры на ксеноне [1] и водороде [2]. В кристалле  $BeSO_4$  прозрачном до  $1700 \text{ \AA}$  [12] использование полосы  $\approx 5 \cdot 10^2 \text{ см}^{-1}$  ксенонового лазера возможно при плотности мощности  $\approx 10^3 \text{ Мвт/см}^2$ . Пороговая интенсивность накачки,  $I_{\text{пор}}$ , для этого кристалла меньше ( $I_{\text{пор}} \approx 10 + 30 \text{ Мвт/см}^2$ ). Требование к источнику накачки можно определить из графиков рисунка ( $I_{\text{пор}} = S_H \Delta\nu_H^{\text{ЭФФ}}$ ). Многочастотный водородный лазер можно использовать для накачки ПГС на центросимметричных кристаллах типа  $MgF_2$ ,  $LiF$  во внешнем статическом поле. Здесь требуются однако плотности мощности  $\approx 10^4 \text{ Мвт/см}^2$ . В рентгеновском диапазоне в области где наблюдался когерентный грехфотонный распад [11],  $\nu' \approx 10^{-8}$ ; этого, по-видимому, недостаточно для компенсации падения нелинейности, даже при использовании мегаамперных [3] электронных пучков в источниках накачки.

7. Интерес к рассмотренным вопросам связан прежде всего с проблемами нелинейной оптики УФ и рентгеновского диапазонов, где степень когерентности мощных источников невелика (см. [1 - 3]). Аналогичные вопросы возникают и в оптике видимого и ИК диапазонов, когда в качестве накачки используется многомодовое излучение или сверхлюминесценция, а также в астрофизике, в частности, в связи с возможностью вынужденного рассеяния интенсивного некогерентного света в космической плазме (см. [4]). Принципиальным является также вопрос о том, в какой мере параметрические генераторы и усилители с широкополосной накачкой способны заменить лазеры в тех областях спектра, где получение лазерного действия затруднено.

Физический факультет  
Московского  
государственного университета  
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию  
13 мая 1971 г.

### Литература

- [1] Н.Г.Басов, В.А.Данилычев, Ю.М.Попов, Д.Д.Ходкевич. Письма в ЖЭТФ, 12, 473, 1970.

- [ 2 ] R.Hodgson. Phys. Rev. Lett., 25, 494, 1970.
  - [ 3 ] В.А.Цукерман, Л.В.Тарасова, С.И.Лобов. УФН, 103, 319, 1971.
  - [ 4 ] K.Shimoda. J. Phys. Soc. Japan., 24, 1380, 1968.
  - [ 5 ] Ю.Е.Дьяконов . Письма в ЖЭТФ, 11, 362, 1970.
  - [ 6 ] С.А.Ахманов, К.Н.Драбович, А.П.Сухоруков, А.С.Чиркин. ЖЭТФ, 59, 485, 1970.
  - [ 7 ] R.Carman, F.Shimizu, C.Wang. N. Bloembergen Phys. Rev., A2, 60, 1970.
  - [ 8 ] С.А.Ахманов, А.С.Чиркин. Изв. высш. уч. зав., сер. Радиофизика. 13, 788, 1970.
  - [ 8 ] М.М.Сушик, В.М.Фортус, Г.И.Фрейдман. Изв. высш. уч. зав., сер. Радиофизика , 13, 631, 1970.
  - [ 10] С.А.Ахманов, М.А.Большов, К.Н.Драбович, А.П.Сухоруков. Письма в ЖЭТФ, 12, 547, 1970.
  - [ 11] P.Eisenberger, S.McCall. Phys. Rev. Lett., 26, 889, 1971.
  - [ 12] Г.Ф.Добржанский, М.П.Головей, Г.И.Косоуров. Письма в ЖЭТФ, 10, 263, 1969.
  - [ 13] Ю.Е.Дьяков. Краткие сообщения по физике (ФИАН), № 7, 1971.
-